(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2003-528849 (P2003-528849A)

(43)公表日 平成15年9月30日(2003.9.30)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F	I	デ	-マコート ゙(参考)
C 0 7 C 253/30		C	0 7 C 253/30		4 C 0 3 4
B 0 1 J 31/24		В	0 1 J 31/24	Z	4G069
C 0 7 C 255/19		C	0 7 C 255/19		4H006
C 0 7 D 201/08		C	0 7 D 201/08		4H039
223/10			223/10		
		審査請求 未請求	予備審査請求 有	(全 26 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-570610(P2001-570610) (86) (22)出願日 平成13年3月14日(2001.3.14) (85)翻訳文提出日 平成14年9月13日(2002.9.13) (86) 国際出願番号 PCT/EP01/02903 WO 0 1 / 0 7 2 6 9 7 (87) 国際公開番号 平成13年10月4日(2001.10.4) (87) 国際公開日 (31)優先権主張番号 00200927.2 平成12年3月14日(2000.3.14) (32)優先日 欧州特許庁(EP) (33)優先権主張国

(31)優先権主張番号 00200926. 4 (32)優先日 平成12年3月14日(2000.3.14) (33)優先権主張国 欧州特許庁(EP) (71)出願人 シエル・インターナシヨナル・リサーチ・

マートスハツペイ・ベー・ヴエー

オランダ国、ザ・ハーグ・2596・ハー・エル、カレル・フアン・ビユランドトラー

ン・30

(72)発明者 ドレント,エイト

オランダ国、エヌ・エルー1031・セー・エ ム・アムステルダム、バドハイスウエヒ・

3

(74)代理人 弁理士 川口 義雄 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ペンテンニトリルのカルボニル化方法

(57) 【要約】

ペンテンニトリルのカルボニル化によって5-シアノ吉草酸またはそのエステルを調製する方法であって、ペンテンニトリルを一酸化炭素および水またはアルコールと触媒系の存在下で反応させる。この触媒系は、(a)第VIII族の金属またはその化合物、(b)一般式(I): $R^1 R^2 - M^1 - R - M^2 - R^3 R^4$ [式中、 M^1 および M^2 は独立にP、As またはSbであり、R は二価の有機架橋基]で表される二座ホスフィン、アルシンおよび/またはスチビン配位子、(c)水性溶液中18℃で測定した場合、3未満のPKaを持つ酸を含む。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ペンテンニトリルをカルボニル化して5-シアノ吉草酸またはそのエステルを調製する方法であって、ペンテンニトリルを一酸化炭素および水またはアルコールと触媒系の存在下で反応させ、該触媒系が、

(a) 第VIII 族の金属またはその化合物、

(b)一般式(I):

 $R \ ^{1} \ R \ ^{2} \ - M \ ^{1} \ - R \ - M \ ^{2} \ - R \ ^{3} \ R \ ^{4}$

Ι

[式中、 M^1 および M^2 は独立にP、A s またはS b であり、R は二価の有機 架橋基であり、前記架橋基は、2 個の燐原子を直接につなぐ3 ~ 5 個の原子の鎖を含み、前記鎖は、炭素原子および場合によっては窒素、酸素もしくは硫黄原子 またはシラノもしくはジアルキルシリコン基からなり、アルキル基は独立に1 ~ 4 個の炭素原子を含み、 R^1 $\sim R^4$ は、同一または異なった置換されていてもよい第3級アルキル基を示す〕で表される二座ホスフィン、アルシンおよび/またはスチビン配位子、

(c)水性溶液中18℃で測定した場合、3未満のpKaを有する酸を含んでなる、前記方法。

【請求項2】 式Iの二座配位子がビスホスフィン配位子であり、R1~R4が同一の第3級アルキル基を示す、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 $R^{-1} \sim R^{-4}$ が第3級ブチル基を示す、請求項1または2に記載の方法。

【請求項4】 R が C_3 ~ C_5 アルキレン基である、請求項1~3のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5】 二座配位子が1,3-ビス(ジーtertーブチルホスフィノ)プロパンまたは1,2-ビス(ジーtertーブチルホスフィノメチル)ベンゼンである、請求項4に記載の方法。

【請求項6】 第VIII族の金属がパラジウムである、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。

【請求項7】 配位子(b)と金属(a)のモル比が1:1~5:1の範囲にある、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】 温度が80~125℃である、請求項1~7のいずれか一項 に記載の方法。

【請求項9】 酸化合物(c)と金属(a)のモル比が1:1~5:1の間である、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法。

【請求項10】 ペンテンニトリルから ϵ – カプロラクタムを調製する方法であって、

(i)請求項1~11のいずれか一項に記載の、ペンテンニトリルの5-シア ノ吉草酸またはエステルへのカルボニル化、

(ii)ステップ(i)で得られた5-シアノ吉草酸またはエステルの6-アミノカプロン酸またはエステルへの還元、

(i i i) 前記 6 - アミノカプロン酸またはエステルの ε - カプロラクタムへの環化

を含む方法。

【請求項11】 ステップ(i)で得られた分岐鎖および直鎖のカルボニル 化生成物の混合物をステップ(ii)および/またはステップ(iii)で使用 する、請求項10に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

発明の背景

本発明は、触媒系の存在下でペンテンニトリルをカルボニル化して5-シアノ 吉草酸またはそのエステルを調製する方法、およびこのようなカルボニル化方法 を用いるε-カプロラクタムを調製する方法に関する。

[0002]

εーカプロラクタムを調製する分野においては、ブタジエンに基づく新しいルートが大いに必要とされている。工業的にεーカプロラクタムを調製する方法では、フェノールまたはシクロヘキサンのどちらかを出発化合物として使用する。これらのルートの不利な点は、硫酸アンモニウムが望ましくない副生成物として産生されることである。さらに、これらの知られている方法は多くの処理ステップを含み、εーカプロラクタムの調製が面倒かつコスト高なものとなっている。

[0003]

εーカプロラクタムのブタジエンをベースとする調製方法が記載されている最近の特許文献においては、まずブタジエンのカルボニル化によってペンテノエートエステルを調製し、このエステルを次にヒドロホルミル化ステップで反応させて5ーホルミル吉草酸エステルとする。この5ーホルミル吉草酸エステルは続いて還元性アミノ化ステップにおいて6アミノカプロン酸またはそのエステルに変換される。その後、6ーアミノカプロン酸またはそのエステルは水性媒体中で加熱すると、反応してεーカプロラクタムとなる。USーAー5693851、(140℃においてパラジウムの触媒作用を利用したブタジエンのカルボニル化が記載されている)によれば、3ーおよび4ーペンテン酸メチルエステルに対する最良の選択性は約93%である。USーAー6018081(メチルペンテノエートエステルのロジウムの触媒作用を利用したヒドロホルミル化を記載している)によれば、5ーホルミル吉草酸メチルエステルに対する最良の選択性は81%である。EPーAー729943およびWOーAー9837063によれば、還元性アミノ化および環化ステップにおいて5ーホルミル吉草酸メチルのεーカプロラクタムへの変換が100%達成可能である。このように、ブタジエンに基づ

いて全体の選択性は最高でも約75%である。これは出発ブタジエンの25%が 廃棄しなければならない副生成物に変換されることを意味している。工業的応用 を考える前に、この全体の選択性を著しく改良しなければならないということが 明らかであることは確かである。

[0004]

DE-A-19840253は、5-シアノ吉草酸およびそのエステル類から 出発してカプロラクタムを調製する方法の可能性を記載している。6-アミノカ プロン酸、各6-アミノカプロン酸エステルに対して水素を添加し、水またはア ルコールを除去することにより、カプロラクタムが得られる。

[0005]

DE-A-19840253はさらに、パラジウム(II)化合物、二座ジホスフィンおよびアニオン供給源を含む触媒系の存在下で、ペンテンニトリルを水またはアルカノールおよび一酸化炭素と反応させてシアノ吉草酸またはエステルを調製する方法に関している。DE-A-19840253は、3頁29~36行に、可能な二座ジホスフィン配位子類の広範なリストを挙げている。このリストには、例えば、1,2ービス(ジーnーブチルホスフィノ)エタン、1,3ービス(ジメチルホスフィノ)プロパン、1,3ービス(ジーイソプロビルホスフィノ)プロパンおよび1,2ービス(ジーシクロヘキシルホスフィノ)エタン、ならびに1,3ービス(ジーtertーブチルホスフィノ)プロバンが含まれている。加えて、DE-A-19840253は、4頁55~62行にアニオン類の可能な供給源の全範囲を挙げているが、この中では9ーアントラセンカルボン酸等のpKa3.5以上の弱い有機酸類が好ましい。

[0006]

DE-A-19840253は、実施例の中で、パラジウム(II)酢酸、9 ーアントラセンカルボン酸および1,2ービス(ジシクロヘキシルホスフィノ) エタンまたは1,2ービス(1,5ーシクロオクチレンホスフィノ)エタンと1 ,2ービス(1,4ーシクロオクチレンホスフィノ)エタンの混合物の存在下で 、3ーペンテンニトリルをメタノールおよび一酸化炭素と150℃の温度で反応 させることによって5ーシアノ吉草酸メチルを調製することを記載している。4 ○から90%の範囲の変換率において、所望のメチル5-シアノ吉草酸に対する 選択性が70から72%の範囲で得られた。

[0007]

US-A-4950778は、コバルト触媒の存在下で圧力136バールおよび温度200℃で3-ペンテンニトリルを水および一酸化炭素と反応させることによって5-シアノ吉草酸を調製する方法を記載している。87.4%の変換率で、望ましくない分岐のC6酸に対する選択性は9.1%で、また望ましくないバレロニトリルに対する選択性は9.6%であった。

[0008]

US-A-5434290は、コバルト触媒の存在下で圧力200バールおよび温度160℃で、3-ペンテンニトリルをメタノールおよび一酸化炭素と反応させることによってメチル5-シアノ吉草酸を調製する方法を記載している。66%の変換率で、所望されるメチル5-シアノ吉草酸に対する選択性は約89%であった。

[0009]

上記諸方法の不利な点は、操作圧力および/また操作温度が高いこと、コバルトカルボニル化合物を高濃度で使用すること、および/または比較的低い変換率では選択性が低いことにある。

[0010]

US-A-5679831は、パラジウム、1,1'ービス(ジイソプロピルホスフィノ)フェロセンおよびpートルエンスルホン酸からなる触媒系の存在下、圧力60バールおよび温度130℃で、3ーペンテン酸メチルをメタノールおよび一酸化炭素と反応させることによって3ーペンテン酸メチルをアジピン酸ジメチルにカルボニル化することを記載している。99%の変換率で、アジピン酸ジメチルに対する83%の選択性が得られた。90℃で行われた別の実験では、71%のペンテノエート変換率においてアジペートに対する84%の選択性が実証された。すべての実験はペンテノエートから出発して、10を上回る酸対パラジウムモル比で行った。可能な基質としてペンテノエートの代わりにペンテンニトリルが挙げられている。しかしながら、仮にペンテンニトリルを同じ配位子を

用いてまた実施例と同じ条件下でメチルー3ーペンテノエートの代わりに使用しても、触媒活性は認められない。もう1つの不利な点は、酸濃度が高いために反応混合物が腐食性となり、ホスフィン化合物の酸およびオレフィン化合物による 四級化により、配位子の分解が進む結果となる。

[0011]

EP-A-495548は、パラジウム、1,3-ビス(ジーtert-ブチルホスフィノ)プロパンおよびメチルスルホン酸の存在下で圧力30バールおよび温度60℃で、プロペンをメタノールおよび一酸化炭素と反応させることによってプロペンをカルボニル化することを記載している。所望される直鎖メチルブタノエートに対する選択性は86%であった。

[0012]

発明の概要

本発明は、5 - シアノ吉草酸またはそのエステル類を高い収率でかつ穏やかな 処理条件で調製するための方法を提供することを目的としている。

[0013]

本目的は次の方法によって達成される。ペンテンニトリルをカルボニル化して 5 - シアノ吉草酸またはそのエステルを調製する方法であって、ペンテンニトリルを一酸化炭素および水またはアルコールと触媒系の存在下で反応させ、該触媒系が、

(a) 第VIII 族の金属またはその化合物、

(b)一般式(I):

 $R \, {}^{1} \, R \, {}^{2} \, - M \, {}^{1} \, - R \, - M \, {}^{2} \, - R \, {}^{3} \, R \, {}^{4}$

[式中、 M^1 および M^2 は独立にP、A s またはS b であり、R は二価の有機架橋基であり、前記架橋基は、2 個の燐原子を直接につなぐ3~5 個の原子の鎖を含み、前記鎖は、炭素原子および場合によっては窒素、酸素もしくは硫黄原子またはシラノもしくはジアルキルシリコン基からなり、アルキル基は独立に1~4 個の炭素原子を含み、 R^1 ~ R^4 は、同一または異なった置換されていてもよい第3級アルキル基を示す〕で表される二座ホスフィン、アルシンおよび/またはスチビン配位子、

(c)水性溶液中18℃で測定した場合、3未満のpKaを有する酸を含んでなる前記方法。

[0014]

本発明による方法によって、5 - シアノ吉草酸またはエステルは、操作圧力および/または温度については穏やかな処理条件下で、高い収率で得ることができることがわかった。

[0015]

DE-A-19840253を斟酌すると、意図的に選択したb)の二座ジホスフィン類とc)の酸の組み合わせの存在下でペンテンニトリルをカルボニル化することで、直鎖生成物がそれほど高い収率で得られるであろうとは予想されなかった。特に今、DE-A-19840253で挙げられている二座ジホスフィン類のいくつかを本発明による方法において使用しても、本発明の実施例に示すように、非常に貧弱な結果が得られるだけである。

[0016]

EP-A-495548を斟酌すると、ペンテンニトリルから出発するほうが、前記公報に例示されているようにプロペンのようなより単純な分子から出発する場合よりも直鎖生成物に対する高い選択性が得られようとは予測されていなかった。US-A-5679831を斟酌すると、あまり好ましいとはいえない出発化合物の1つとして引用されている化合物を使用した場合に、前記公報に開示された化合物よりも高い収率でジメチルアジペートが得られるとは予測外である

[0017]

本方法は比較的低い温度で実施可能であるので特に有利である。パラジウム、ホスフィン類および酸類を含む触媒系の使用にしばしば生じる問題は、高い温度、特に120℃を上回る温度で工業的に応用するためには触媒の安定性があまりに低くなることにある。本触媒は120℃未満の温度、特に110℃未満の温度で、工業的に許容可能な活性をもっているので、本方法によって消費される触媒は少なくて済むことになる。

[0018]

加えて、本発明による方法はεーカプロラクタムを調製する方法に有利に利用できる。εーカプロラクタムはペンテンニトリルに基づいて高い選択性を持って得られる。このペンテンニトリルはまたUS-A-5821378によればブタジエンから95%を上回る高い選択性で調製可能である。ペンテンニトリルの5-シアノ吉草酸またはエステルへのカルボニル化は、ペンテンニトリルの96%変換において、5-シアノ吉草酸エステルに対して96%の選択性を持って行われることが今のところわかっている。εーカプロラクタムを得るため、6-アミノカプロン酸、各6-アミノカプロン酸エステルに対して水素を添加し、水またはアルコールを除去することは、EP-A-729943およびWO-A-9837063に実証されるように、化学的には還元型アミノ化および環化ステップと非常に類似している。したがってこれらのステップに匹敵する約100%の選択性が想定される。ブタジエンから95%の選択性で得られたペンテンニトリルを使用することによって、本方法ではブタジエンに基づいてεーカプロラクタムに対する全体の選択性約90%が可能となる。

[0019]

発明の詳細な説明

第VIII族の金属の中では、コバルト、ニッケル、バラジウム、ロジウムおよびプラチナが挙げられる。これらのうちパラジウムが特に好ましい。第VIII族の金属供給源として以下さらに例を挙げると、パラジウム源としては、金属パラジウムもしくはパラジウム化合物は、式(I)によって特定された配位子のパラジウム錯体の形で供給されてもよい。また好都合なことに、パラジウム化合物は、パラジウム供給源および配位子供給源を反応に加えることによってもインシトゥに生成し得る。パラジウムの適切な供給源には、Pd(O)(ジベンジルアセトン)2、酢酸パラジウム、プロピオン酸パラジウム、酪酸パラジウムまたは安息香酸パラジウム、プロピオン酸パラジウム、酪酸パラジウムまたは安息香酸パラジウム、アセチルアセトン酸バラジウム、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムおよびビス(トリオトリルホスフィン)酢酸パラジウム等のパラジウム

異なる形態、例えば、イオン交換樹脂に充填する等の形態で使用してもよい。

[0020]

好ましくは、アルカン酸のパラジウム塩、例えば酢酸、プロピオン酸またはトリフルオロ酢酸といった特に炭素原子12個までのアルカン酸が使用される。

[0021]

式 I の二座において、 M^1 、 M^2 は同一であって、特にそれらは両者とも燐原子を示すことが好ましい。

[0022]

好ましいパラジウム原子に対して二座配位を可能にするために、触媒系の二座ジホスフィン配位子は二座配位モードに対して立体障害を与える置換基を含まない方がよい。特に、二価の架橋基Rは立体障害を与える置換基を含まない方がよい。架橋基Rは好ましくは3から20個の原子からなる有機二価の基である。好ましくは、この2個の燐原子を結合している原子の鎖は末端のヘテロ原子を含まない。より好ましくは、架橋基は炭素原子のみからなる。可能な架橋基の例としては、置換されているかまたは置換されていない二価のアリール基、例えばジキシリルがある。架橋基のもう1つの好ましい基としては、C3~C5アルキレン基、すなわち、トリメチレン、テトラメチレンおよびペンタメチレンがあり、このうちトリメチレンがもっとも好ましい。

[0023]

架橋基は、場合によっては、置換基が二座配位子の配位形態に対して立体障害を与えないものであることを前提に1つまたは複数の置換基によって置換されていてもよい。可能な置換基の例としては、例えば1から4個の炭素原子を持つアルキル基がある。

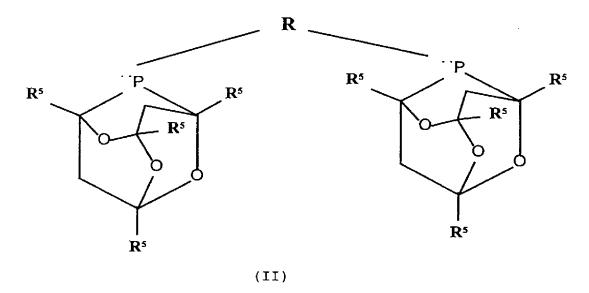
[0024]

本明細書において、R¹からR⁴で示されるアルキル基は環構造を包含する。R¹およびR²および/またはR³およびR⁴は1つの環状構造を形成してもよい。場合によってはヘテロ原子を含んでいてもよい。より好ましくは、R¹およびR²および/またはR³およびR⁴は二価のラジカル(遊離基)を示す。この二価のラジカルは、(燐原子と一緒になっている、つまりこの燐原子に二価のラ

ジカルが付加している)アルキルに置換された2-ホスファトリシクロ[3.3.1] . 1.1(3,7)] デシル基またはその誘導体であって、その1つまたは複数の炭素原子がヘテロ原子に置換されている。好ましくは、アルキルに置換された2-ホスファートリシクロ[3.3.1.1(3,7)] デシル基を含む配位子は、式1 I に従う化合物である。この式中R 5 は、1 ~ 6 個の炭素原子のアルキル基、好ましくはメチルである。このような配位子の例およびその調製は、W O - A - 9 8 4 2 7 1 7 に詳しく記載されている。

[0025]

【化1】



好ましくは、第3級アルキル基は、非環状第3級アルキル基である。適切な非環状第3級アルキル基の例には、 $tert-ブチル、2-(2-メチル)ブチル、2-(2-メチル)ブチル、2-(2-メチル)ブチルがある。<math>R^1$ から R^4 基は同一の第3級アルキル基を示すのが好ましく、 R^1 から R^4 基はtert-ブチル基であることが最も好ましい。

[0026]

可能な配位子の例には、1, 4-ビス(ジーtert-ブチルホスフィノ)ブタン、1, 5-ビス(ジーtert-ブチルホスフィノ)ペンタン、1, 3-ビス(ジー2-(2-メチル)ブチルホスフィノ)プロパン、1, 3-ビス(ジー2-(2-エチル)ブチルホスフィノ)プロパン、1, 3-P, 1P, 1P,

ホスファー1, 3, 5, 7-テトラメチルー6, 9, 10-トリオキサトリシクロ[3.3.1.1{3.7}] デシル) プロパン (DPA3)、1, 4-P, P'-ジ(2-ホスファー1, 3, 5, 7-テトラメチルー6, 9, 10-トリオキサトリシクロ[3.3.1.1{3.7}] デシル) ブタン、1, 2-ビス(ジー2-(2-メチル) ブチルホスフィノメチル) ベンゼンがある。

[0027]

特に好ましい二座配位子は:1,3-ビス(ジ-tert-ブチルホスフィノ)プロパンおよび1,2-ビス(ジ-tert-ブチルホスフィノメチル)ベンゼンである。ここで架橋基は、場合によっては、上記で記載されたようにさらに置換されていてもよい。

[0028]

3. 〇未満のPKaを有する酸は非配位アニオンを持つことが好ましい。これは、パラジウムとこのアニオンの間に共有的な相互作用が少ししかないかあるいはまったくないことを意味する。このようなアニオンの典型的な例には、PF6一、SbF6一、BF4一、およびC1〇4一がある。好ましい酸は、例えばスルホン酸、および、例えばBFョ、AsF5、SbF5、PF5、TaF5、またはNbF5等のルイス酸と例えばハイドロハロゲン酸、特にHF、フルオロスルホン酸、燐酸、または硫酸等のブレンステッド酸とを相互作用させてインシトゥで形成され得る酸である。後者の酸の具体的な例には、フルオロ珪酸、HBFョ、HPF6、およびHSbF6がある。適切なスルホン酸の例にはフルオロスルホン酸、クロロスルホン酸、およびこれ以降指定されるスルホン酸がある。3. 〇未満のPKaを持つ酸の好ましいグループは一般式IIIを有する。

[0029]

【化2】

ここで、Xは硫黄または塩素原子を示し、Xが塩素原子を示す場合R6は酸素原子を示し、またXが硫黄原子を示す場合R6は〇日基または炭化水素基、例えばアルキル基またはアリール基を示す。これらは置換されていても置換されていなくてもよい。一般式IIIの適切な酸の例には、過塩素酸、硫酸、2ーヒドロキシプロパン-2-スルホン酸、p-トルエンスルホン酸、tert-ブチルスルホン酸、メチルスルホン酸がある。一般式IIIの酸はまた、スルホン酸基を含むイオン交換体、例えばアンバーライト252H(「アンバーライト」は商品名)等であってよい。その場合、炭化水素基R6はスルホン酸基で置換された高分子炭化水素基(例えばポリスチレン基等)を示す。

[0030]

もう1つの可能な酸は次の一般式IVに従う。

[0031]

【化3】

ここで、R7は、-OH基または、例えばアルキル基またはアリール基といった 炭化水素基である。これらは置換されていても置換されていなくてもよい。例と しては燐酸、メチルホスホン酸、フェニルホスホン酸がある。

[0032]

前記に述べた酸を本発明による方法に使用すると、この酸のアニオンは非配位であると考えられる。酸と金属(a)のモル比は、1:1と10:1の間が好ましく、1:1と5:1の間がより好ましい。

[0033]

ハロゲンイオンは腐食性であるので、本発明の触媒系におけるパラジウムの供 給源は、ハロゲン化合物またはハロゲンイオンを生成する化合物でないことが好 ましい。しかし少量のハロゲンの存在は有利である。場合によっては他の促進剤 が存在していてもよい。

[0034]

好都合なことに、本発明の触媒系は、カルボニル化反応に先んじて、別のステップで、パラジウム供給源および式Iの二座配位子を組み合わせることによって得られる。パラジウム化合物は、上記に例示したように、適切な溶媒に溶解し続いて二座配位子と混合することが適切である。この二座配位子と金属(a)のモル比は1:1から5:1の範囲が好ましく、1:1から3:1の範囲がより好ましい。これらの低いモル比が適用可能であることは有利で、それにより、過剰な二座配位子の使用が回避され、よってこれら通常高価な化合物の消費が減らされる。

[0035]

本方法に使用される触媒の量は重要ではない。良好な結果は、第VIII族の金属の量がペンテンニトリル1モルあたり10-7から10-1グラム原子の範囲にある場合に得られる。この量は1モルあたり10-5から5.10-2グラム原子の範囲にあることが好ましい。

[0036]

カルボニル化方法が水の存在下で実施されるとすれば、得られる生成物は5-シアノ吉草酸となる。副生成物はおもに少量の分岐シアノ酸となる。5-シアノ吉草酸は、本発明による方法によって得られるように、好ましくは5-シアノ吉草酸エステルの加水分解によって得られる。

[0037]

本発明による方法において、カルボニル化がアルコールの存在下で実施されるなら、5ーシアノ吉草酸エステルは直接的に得られる。適切なアルコールには、特に、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、イソプロパノール、フェノール等の1モルあたり1~6個の炭素原子を持つ脂肪族一価アルコール、およびエチレングリコール、1、3ープロパンジオール等の二価アルコールが含まれる。特にメタノールが好ましい。5ーシアノ吉草酸エステルを生成物として所望する場合、水の存在を避けるのが好ましい。本方法は、例えばトリメチルオルソホルマートといった水回収剤の存在下で行われるのがより好ましい。

[0038]

アルコールまたは水の量は重要ではない。水またはアルコールのペンテニトリルに対するモル比は、等モルあたりから水またはアルコールが過剰である範囲でよい。アルコールまたは水は場合によっては反応溶媒としても作用するが、所望であれば別個の溶媒も使用し得る。

[0039]

別の溶媒は、もし存在するなら、パラジウム化合物と弱く配位する化合物が好ましい。適切な溶媒の例には、アセトニトリル、エタノール、アセトン、アセチルアセトン、トルエン、スルホラン、およびエーテル類:例えばジエチレングリコールのジメチルエーテル、アニソールジフェニルエーテルがある。

[0040]

本発明によるカルボニル化反応は、中程度の温度および圧力で実施される。適切な反応温度は50~250℃の範囲、好ましくは80~125℃の範囲である。反応圧力は通常少なくとも大気圧である。適切な圧力は1~100バールの範囲、好ましくは5~50バールの範囲である。

[0041]

本反応に必要とされる一酸化炭素は、実質的に純粋な形で供給され得るかあるいは窒素、水素等の不活性化合物が通常は少量で混入していてもよい。

[0042]

本方法は、バッチ操作あるいは連続して実施し得る。本方法の連続操作に関連した実施形態では好都合なことに、生成物は触媒系から蒸留によって、好ましくはワイプトフィルムエバボレータ(wiped film evaporator)中で単離される。あるいは、生成物は反応混合物からガスを使用して取り出すこともできる。

[0043]

出発ペンテンニトリルは、2-、3-または4-ペンテンニトリルかまたはその混合物でよい。これらすべての出発化合物から、本発明による方法によって直鎖生成物に対する高い選択性が得られることがわかった。ペンテンニトリルは、ブタジエンおよびシアン化水素から出発する、例えば、US-A-4, 298, 546およびUS-A-5,821,378に記載された方法によって有利に得

られる。

[0044]

5ーシアノ吉草酸またはエステルはアジピン酸またはそのエステルを調製するための中間生成物として使用され得る。アジピン酸はシアノ基のエステル化によって得られる。アジピン酸はナイロンー6.6への前駆体である。ナイロンー6.6の別の前駆体は、1,3ジーシアノプロパンであり、これはペンテンニトリルから調製され得る。したがって、本方法はナイロンー6.6またはその前駆体のメーカーに対して、1,3ジーシアノプロパンを調製するために既に使用されている前駆体からアジピン酸への好適なルートを提供する。

[0045]

本発明の方法によって調製された5-シアノ吉草酸またはエステルは、ε-カ プロラクタムを調製するための方法にさらに有利に使用され得る。

[0046]

本発明はまたこのようにペンテンニトリルから ε - カプロラクタムを調製する 方法をも提供する。その方法は

- (i)本明細書上記に記載された方法によるペンテンニトリルの5-シアノ吉 草酸またはエステルへのカルボニル化、
- (ii)ステップ(i)で得られた5-シアノ吉草酸またはエステルの6-アミノカプロン酸またはエステルへの還元、
- (i i i) 6-アミノカプロン酸またはエステルの ε-カプロラクタムへの環化を含む。

[0047]

このステップ(i)で得られた5-シアノ吉草酸またはエステルは同種の触媒系から例えば、蒸留、抽出、相分離、または結晶化(中でも、蒸留が好ましい)によって分離され得る。触媒系は、カルボニル化反応の中で再び有利に使用される。

[0048]

たとえ高選択性がステップ(i)で達成されたとしても、副生成物がいくつか 形成される。これらの副生成物は、例えば、5シアノ吉草酸またはエステルから 蒸留によってまたは上記に記載の技法のどれかによって分離される。しかし問題は所望の直鎖生成物が、副生成物として形成される分岐生成物から蒸留によって分離することが困難であることである。したがって、有利な実施形態においては、ステップ(i)で得られた分岐および直鎖のカルボニル化された生成物の混合物をステップ(ii)で使用し、場合によってはステップ(iii)でも使用する。これによって、ステップ(i)の後の精製ステップの(作業)量をさらに有利に削減することになる。ステップ(iii)の後は、εーカプロラクタムの精製は過酷なので、これらの精製ステップとカルボニル化の副生成物の分離を組み合わせることは有利である。

[0049]

これは本発明の方法で特に可能である。というのは、副生成物の含有量が現況技術のεーカプロラクタムに至る反応経路と比較すると少ないからである。この実施形態は、5シアノ吉草酸がステップ(i)で得られる生成物である場合にさらに特に有利である。沸点が近いことを考慮すると、分岐化合物類を所望の5ーシアノ吉草酸から分離することは簡単ではない。ステップ(i)でこれらの酸を分離しないで、その代わりにステップ(ii)および(iii)で混合物として処理することによって、より簡便な方法となる。ステップ(iii)後に生じる分岐ラクタムからεーカプロラクタムを分離することは、例えば結晶化あるいは蒸留によって簡単に行うことができる。

[0050]

場合によってはステップ(i)で使用された同種の触媒をステップ(ii)の後、反応混合物から分離する。

[0051]

ステップ(ii)は、よく知られている還元技法によって行い得る。このステップでは、水素をステップ(i)で得られたシアノ化合物と、還元触媒、適切にはCuまたは第VIII族金属(例えばPt、Pd、Ni、Co、RuまたはFe)の存在下で接触させる。この触媒は同種の触媒、例えばステップ(i)で使用された触媒である。好ましくは異種の触媒を使用する。還元触媒の例としては、ラネーNi、ラネーコバルトおよびCo/Cu触媒がある。

[0052]

ステップ(iii)は適切な溶媒中、高温で適宜行われる。適切な溶媒は、水、高沸点の炭化水素およびアルコールであり、好ましくは6ーアミノカプロエートエステルに対応するアルコールである。ステップ(iii)では、例えばUS-A-5780623で記載されたように、好ましくは水を溶媒として使用し、また6-アミノカプロン酸を出発化合物として使用する。温度は280と400℃の間が好ましい。ステップ(i)で5-シアノ吉草酸エステルが得られるなら、還元ステップ(ii)または環化ステップ(iii)に先だって、この化合物をその対応する酸にまず加水分解することが有利である。あるいは、WO-A-9837063に例示されているように、ステップ(ii)の水素添加された生成物、すなわち、6-アミノカプロン酸またはそのエステルを、超加熱された蒸気の存在下で温度270から350℃、圧力5から20バールで反応させてε-カプロラクタムとしてもよい。

[0053]

本発明は、次の非制限的な実施例によって例示される。

[0054]

実施例1~9および比較例A~D

実施例1~9および比較例A~Dは、磁気的に攪拌される250m1のオートクレーブ(ハステロイC(Haste11oy C、(商標))中で実施した。オートクレーブにメタノールおよび任意の溶媒を所与の量、3-ペンテンニトリルを20m1、0.25ミリモルのパラジウム(II)酢酸、選択されたホスフィンおよび酸を所与の量充填した。酢酸パラジウム/ホスフィンを窒素雰囲気下で充填した。オートクレーブを閉じた後、排気を行い、60パールの一酸化炭素をそこに供給した。オートクレーブを所望の温度にまで加熱した。初期のカルボニル化の速度は、反応最初の一時間の単位時間あたりの圧力の低下から決定した。全体として10時間の反応を行った後、オートクレーブを室温まで冷却し、その後徐々に圧力を低下させた。シアノエステル生成物の選択性および直鎖性および変換率は反応生成物のガス液体クロマトグラフィ分析によって決定した。溶媒、分量、条件および結果については表1参照のこと。

[0055]

実施例10

1、3-P, $P'-\tilde{\nu}$ ($2-\pi Z Z r-1$, 3, 5, $7-\tilde{\gamma} P + \tilde{\gamma} Z T r-6$, 9, 10-P リオキサトリシクロ $[3.3.1.1 \{3.7\}$ デシル] プロパン(DPA3)を配位子として、0.5 ミリモルの CH_3SO_3H 、10m1のペンテンニトリル、および40m1のメタノールの存在状態、115 C にて使用した以外は実施例1を繰り返した。初期速度は(モル/モル/時間)は100 であった。変換率は10 時間後で70%であった。シアノエステル類の選択性は98%であった。直鎖率は88%であった。

[0056]

実施例11

オートクレーブに10m1のメタノール、40m1のアニソール、20m1の 2 ーペンテンニトリル、0.25ミリモルのパラジウム(II)酢酸、0.6ミ リモルの1,3-ビス(ジーtert-ブチルホスフィノ)プロパンおよび2ミ リモルのtert-ブチルスルホン酸を充填した以外は実施例1を繰り返した。 パラジウム酢酸/ホスフィンを窒素雰囲気下で充填した。オートクレーブを閉じ た後、排気を行い、60バールの一酸化炭素をそこに供給した。オートクレーブ を125℃まで加熱した。初期速度(モル/モル/時間)は200であった。変 換率は4時間後で74%であった。シアノエステル類の選択性は98%であった 。直鎖率は92.5%であった。

[0057]

【表1】

配位子 (ミリモル) 1,3ーピス (ジーtertー ブチルホスフィノ) プロパン (0.6) 1,3ーピス (ジー		‡ H			世代の神にて		1.17 / 十/ 上!	
3ーピス (ジーtert チルホスフィノ) ロパン (0.6) 3ーピス (ジー			风心媒体 (ml)	題の	が別込を (モル/ モル/時間)	変換率 (%)	ノノノエヘノル に対する選択性 (モル%)	直鎖性 (モル%) (1)
3ービス (ジーンプロピルポス)		CH,SO ₃ H (2)	CH,OH (40)	115	88	88	8	81
プロパン (0.6)		周上 (2)	周上 (40)	115	後	V	I	ŀ
1,3ービス (ジーtertー ブチルホスフィノ) ブロパン (0.6)	J.	同上 (2)	同上 (40)	100	300	22	86	88
1,3ービス (ジーtertー ブチルホスフィノ) プロパン (0.6)	I.	同上 (1)	同上 (40)	901	350	28	86	8
1,3ーピス (ジーtertー ブチルホスフィノ) プロパン (0.6)		t-BusO ₃ H (2)	同上 (40)	100	350	8	86	8

実施例	配 位子 (ミリモル)	酸 (ミリモル)	及応媒体 (ml)	温度 (C)	初期速度 (モル/ モル/時間)	変換率 (%)	シアノエステル に対する選択性 (モル%)	直鎖性 (モル%) (1)
ರ	1,3ービス (ジーtertー ブチルホスフィノ) プロパン (0.6)	周上 (2)	同上 (40)	8	250	87	86	\$
ထ	1,3ービス (ジーtertー ブチルホスフィノ) プロパン (0.6)	同上 (2)	同上 (40)	125	400	9 6	86	8
/	1,2ービス (ジーtertー ブチルホスフィノ) エタン (0.6)	同上 (2)	同上 (40)	901	<10	മ	8	&
ω	1,3ービス (ジーtertー ブチルホスフィノ) プロバン (0.6)	同上 (2)	CH ₃ OH (10)、 アニソール (30)	001	400	8	88	8
Ф	1,3ーピス (ジーシクロ ヘキシルホスフィノ) プロパン (0.6)	同上 (2)	CH ₂ OH (10)、 アニソール (30)	92	海	8	I	l

実施例	配 拉子 (三リモル)	酸 (ミリモル)	反応媒体 (m)	(0)	が開速度 (モル/ モル/時間)	変換率 (%)	シアノエステル に対する選択性 (モル%)	直鎖性 (モル%) (1)
ပ	1,1'ーピス (ジー イソプロピルホスフィノ) フェロセン (0.6)	同上 (2)	СН ₃ ОН (10)、 アニソール (30)	100	微電	8	I	ı
6	1,2ービス (ジーtertー ブチルホスフィノメチル) ベンゼン (0.6)	CH ₃ SO ₃ H (1)	CH ₃ OH (10)、 アニソール (30)	100	150	ക	86	86
۵	D トリーtertーブチル ホスフィン (モノホスフィン) (0.6)	同上 (1)	CH ₃ OH (10)、 アニソール (30)	001	微車	₽	I	1

注:中間変換物におけるペンテンニトリルの組成は、シス+トランス-2-ペンテンニトリルの混合物を示し、シス+トランス-3-ペンテンニトリルは、すべての異性体が4シアノメチルペンタノエートに変換され得ることを示している。 (1) 直鎖生はすべてのシアノエステル類に対する5ーシアノ吉草酸エステルのモル%である。

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH F	REPORT	Inter: Ronal App	ol(cation (No
			PCT/EP 01	/02903
A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C07C253/30 C07C255/19 B01J31/2	24 B01J3	31/18	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classificati	on symbols)		
IPC 7	CO7C B01J CO7D			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are	included in the fields s	earched
Electronic da	ata base censulted during the international search (name of data ba	se and, where prac	tical, search terms used	i)
BEILST	EIN Data, CHEM ABS Data, EPO-Interna	11		
_	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages		Relevant to claim No.
A	DE 198 40 253 A (BASF AG) 9 March 2000 (2000-03-09) cited in the application claims; examples			1,11
A	EP 0 495 548 A (SHELE INT RESEAR) 22 July 1992 (1992-07-22) cited in the application claims	CH)		1,11
A	US 5 679 831 A (SIELCKEN OTTO E) 2I October 1997 (1997-10-21) cited in the application claims			1,11
		-/		
X Funt	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent ta	mily members are listed	іл аппех.
A docume	legories of cited documents : of defining the general state of the lart which is not erect to be of perficular relevence.	or priority dat cited to under	published after the inte e and not in conflict with stand the principle or th	the application but
'E' earlier d filing d	locument but published on or after the international ate nt which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be con	articular relevance; the onsidered novel or canno- rantive step when the do	t be considered to
citation O" decume other r		cannot be con document is a ments, such o	articular relevance; the one sidered to involve an incombined with one or moternism about the side of the combination being obvious.	ventive step when the are other such docu-
'P' docume later th	nt published prior le the international filing date but an the priority date claimed		nber of the same patent	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailin	g of the international se	arch report
21	December 2001	14/01	/2002	
Name and n	nailing address of the ISA European Patert Office, P.B. 5818 Paterilian 2 ML - 2288 W Rijswijk Teil. (431-79) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Authorized off		
	Fax: (+31 ~ 70) 340 ~ 2016, 1x, 31 651 epo ni, Fax: (+31 ~ 70) 340 ~ 3016 10 (second sheet) (July 1992)	Sánch	nez García, J	.M.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Inter formal Application No PCT/EP 01/02903

		PCT/EP 01	./ 02903
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		In
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant pessages		Relevant to claim No.
A	WD 97 30973 A (DSM NV ;DU PONT (US); GUIT RUDDLF PHILIPPUS MARIA (NL); LANE SAMUE) 28 August 1997 (1997-08-28) page 1 -page 2		11

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Jornation on patent family members

Interc fional Application No PCT/EP 01/02903

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19840253	A	09-03-2000	DE AU BR WO EP	19840253 A1 5858999 A 9913404 A 0014055 A2 1107947 A2	09-03-2000 27-03-2000 22-05-2001 16-03-2000 20-06-2001
EP 0495548	A	22-07-1992	CA DE DE EP CN DE EP SF KR SG	2059236 A1 69204691 D1 69204691 T2 0495548 A2 2077337 T3 5058949 A 2059233 A1 1063277 A ,B 69210054 D1 69210054 T2 0495547 A2 2088082 T3 4334340 A 220824 B1 45352 A1	16-07-1992 19-10-1995 11-04-1996 22-07-1992 16-11-1995 09-03-1993 16-07-1992 30-05-1996 12-12-1996 22-07-1992 01-08-1996 20-11-1992 15-09-1999 16-01-1998
US 5679831	A	21-10-1997	BE DE DE EP	1008018 A3 69502299 D1 69502299 T2 0662467 A1	12-12-1995 10-06-1998 07-01-1999 12-07-1995
WO 9730973	Α .	28-08-1997	US AU CA CN EP JP WO US	5780623 A 1676097 A 2247463 A1 1216528 A 0882017 A1 2000504743 T 9730973 A1 5973143 A	14-07-1998 10-09-1997 28-08-1997 12-05-1999 09-12-1998 18-04-2000 28-08-1997 26-10-1999

Form PCT/ISA/210 (palent family annex) (July 1992)

フロントページの続き

(51) Int. C1.7 識別記号 // CO7B 61/00 300 EP(AT, BE, CH, CY, (81)指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OA(BF , BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, G M, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ , UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, B Z, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK , DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, J P, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR , LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, R O, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ , TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW (72)発明者 ヤーヘル, ウイレム・ワーベ

(72)発明者 ヤーヘル,ウイレム・ワーベ オランダ国、エヌ・エルー1031・セー・エ ム・アムステルダム、バドハイスウエヒ 3

Fターム(参考) 4C034 DE03

4G069 AA06 BA21A BA21B BA27A BA27B BA42A BC69A BC72A BC72B BE22A BE22B BE26A BE26B BE27A BE31A CB25 CB72

4H006 AA02 AC46 AC48 BA17 BA25 BA48 BA52 BB14 BB31 BC10 BC32 BE40 QN30 4H039 CA65 CA66 CF10 FI CO7B 61/00 300 (参考)